

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**  
**PUBLIC RELATIONS DIVISION**  
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japon

**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE**

**N° 3018**

*Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.*

*Demandes de renseignements des clients*

*Contacts presse*

Power Device Overseas Marketing - Dept.A et Dept.B  
Mitsubishi Electric Corporation

Public Relations Division  
Mitsubishi Electric Corporation  
[prd.news@nk.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:prd.news@nk.MitsubishiElectric.co.jp)

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/)

[www.MitsubishiElectric.com/news/](http://www.MitsubishiElectric.com/news/)

## **Mitsubishi Electric a développé un module de puissance nouvelle génération appelé X-Series New Dual**

*Le module à semi-conducteurs haute puissance nouvelle génération adopte un boîtier standardisé pour plus de flexibilité*

**TOKYO, 6 avril 2016** – [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui avoir développé un module d'alimentation nouvelle génération, baptisé module X-Series IGBT haute tension New Dual, destiné aux applications de traction ou de puissance dans les industries lourdes. Ce nouveau module offre une densité de puissance et un rendement plus élevés aux onduleurs, ainsi qu'un boîtier standardisé permettant de concevoir des systèmes d'onduleurs flexibles.

Des échantillons de la version 3,3 kV (LV100) du module New Dual seront disponibles dès mars 2017. Ensuite, ce sera au tour des versions 1,7 kV, 3,3 kV (HV100), 4,5 kV et 6,5 kV, dans cet ordre, dès 2018. La société prévoit également d'ajouter à la gamme une version de moins d'1,7 kV à l'avenir.

Les modules seront exposés lors de salons majeurs, comme au MOTORTECH JAPAN 2016 lors de l'exposition TECHNO-FRONTIER 2016 qui se déroule au Japon du 20 au 22 avril, ou encore au Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2016 à Nuremberg, en Allemagne, du 10 au 12 mai, et au PCIM Asia 2016 à Shanghai, en Chine, du 28 au 30 juin.



Boîtier du module LV100  
Isolation 6 kV



Boîtier du module HV100  
Isolation 10 kV

Les modules haute puissance sont la clef de voûte du contrôle de la conversion de puissance au sein des systèmes électroniques, dans une large plage de puissance allant de plusieurs kilowatts à plusieurs mégawatts. Jusqu'à maintenant, seuls des modules affichant une tension nominale allant jusqu'à 6,5 kV et un courant nominal de quelques milliers d'ampères ont été commercialisés.

Le nouveau module IGBT haute tension New Dual satisfera les besoins en semiconducteurs à densité de puissance élevée dans une large plage de tensions et de courants nominaux, tout en favorisant une puissance et un rendement optimaux des onduleurs grâce aux diodes RFC et IGBT de septième génération. En parallèle, les dimensions standardisées du boîtier permettront aux fabricants d'électronique industrielle de simplifier les conceptions et de garantir plusieurs sources aux onduleurs.

### **Fonctionnalités du produit**

#### ***1) Une densité de puissance et un rendement énergétique élevés***

- La septième génération d'IGBT utilisant les diodes CSTBT™ et RFC permet une perte minimale de puissance au sein des systèmes d'onduleurs.
- La technologie de boîtier améliorée et l'inductance parasite faible permettent d'atteindre des performances maximales.
- Trois terminaux principaux CA sur le boîtier du module LV100 distribuent et répartissent la densité du courant, améliorant ainsi les capacités de l'onduleur.

#### ***2) Une taille de boîtier standard pour plus de configurations d'onduleurs et plus de puissance***

- Les modules LV100 et HV100 ont une conception de boîtier standard.
- Des connexions simples et standard permettent d'optimiser la configuration du système et autorisent une large plage de courants nominaux.
- La gamme s'étend de 1,7 à 6,5 kV.
- Flexibilité et évolutivité des configurations système améliorées.

#### ***3) Un nouveau boîtier standardisé pour une conception plus efficace***

- Compatible avec les emplacements des terminaux et équipements de Infineon Technologies AG (Allemagne).

### **Gamme de produits (plan)**

Modèle	Type de boîtier	Tension d'isolation	Tension collecteur-émetteur	Courant nominal maximal	Connexion	Dimensions	Disponibilité des échantillons
Module X-Series IGBT haute tension New Dual	LV100	6 kV	1,7 kV	900 A	2 en 1	L : 100 mm	À partir de 2018
			3,3 kV	450 A		x	Mars 2017
	HV100	10 kV	3,3 kV	450 A		P : 140 mm	À partir de 2018
			4,5 kV	330 A		x	
			6,5 kV	225 A		H : 40 mm	

###

### **À propos de Mitsubishi Electric Corporation**

Forte de ses 90 années d'expérience dans la création de produits haute qualité et fiables, l'entreprise Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) est un leader mondial reconnu pour la fabrication, la mise sur le marché et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines du traitement de l'information et les communications, du développement spatial et des communications satellite, des appareils électroniques grand public, de la technologie industrielle, de l'énergie, du transport et de l'équipement de construction. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires consolidé du Groupe de 4 323 milliards de yens (36 milliards de dollars US) au cours du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2015. Pour plus d'informations, veuillez consulter :

<http://www.MitsubishiElectric.com>

\*À un taux de change de 120 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le 31 mars 2015